1.2.2 載子擴散 (carrier diffusion) 與擴散電流 (diffusion current)

在半導體材料中,除了漂移外,還有另一種可在半導體中產生電流的機制 一擴散(diffusion)。擴散是載子由高濃度區域往低濃度區域流動的過程。由 於半導體中載子(電子或電洞)是帶電的,因此載子的擴散會產生另一個電流 成份稱為擴散電流(diffusion current),且擴散電流是與濃度梯度(concentration gradient)成正比。對電子而言,電子擴散電流密度為:

$$J_{n,diff} = qD_n \frac{dn}{dx}$$
 (1.31)

其中dn/dx為電子濃度對空間的微分或濃度梯度,而比例常數 D_n 稱為電子擴散係數 (diffusion coefficient 或diffusivity) 單位為 cm^2/sec 。考慮圖 1-9 之電子濃度 n 對距離 x 的變化情形,電子濃度隨 x 增加,梯度為正,電子將往負 x 方向擴散。由於電子具有負電荷,因此電流方向是往x 方向。反之,如果電子濃度梯度 dn/dx 為一負值(即電子濃度隨 x 減少),則電子擴散電流密度的方向將會是負 x 方向。

類似地,電洞擴散電流密度為:

$$J_{p,diff} = -qD_p \frac{dp}{dx} \tag{1.32}$$

其中 dp/dx 為電洞濃度梯度,而 D_P 為電洞擴散係數。注意,(1.32)式中有一個負號,因為此擴散電流是流向低的電洞濃度方向。舉例,若電洞濃度隨 x 增加(即梯度 dp/dx>0),電洞將朝負 x 方向擴散(因為負 x 方向的電洞濃度較低),又電洞為正電荷,因此電流方向是負 x 方向,故電洞擴散電流方向與濃度梯度相差一個負號。

若半導體材料中電子與電洞的濃度梯度均存在,則總擴散電流密度Joint為:

$$J_{diff} = qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}$$
 (1.33)